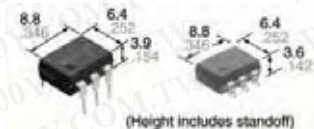


## NAIS\_PCB继电器

详细产品规格 - 请点击 [cn.100y.com.tw](http://cn.100y.com.tw)

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
47374	AQV257	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 200V / 250 mA	1 Form A	200V / 250 mA	200V	UL(E43149),C-UL	AQV257
47379	AQV258	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 1500V / 20 mA	1 Form A	1500V / 20 mA	1500V	UL(E43149),C-UL	AQV258
47378	AQV259	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 1000V / 30 mA	1 Form A	1000V / 30 mA	1000V	UL(E43149),C-UL	AQV259



### 特点:

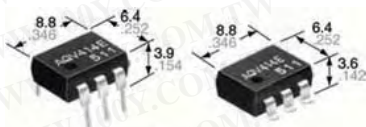
1. 极大地增加的装载电流在同样尺寸包裹。
2. 极大地改善规格允许您使用这在水银和机械中转位置。

### 典型应用

- 犯罪和防火行情(用途在I/O 为警报和安全设备等。)
- 娱乐行情
- 测量仪器行情(电路测试器等。)



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
47367	AQV252G	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 60V / 2.5 A	60V / 2.5 A	60V	UL,C-UL,VDE	AQV252G



### 特点:

1. 60V键入一对大容量(0.55 A)以低在电阻 (1Ω)。

Item	GU-E (1 Form B type) type	
Part No.	AQV410EH	AQV412EH
Load voltage	350V	60V
Continuous load current	0.13A	0.55A
ON resistance (typ.)	18Ω	1Ω

2. 这是低成本版本PhotoMOS 1 种形式B 产品类型中转。

与早先Gu Photo MOS比较1 种形式B 类型中转, 是大约22% 更低更加进一步经济价格扩展市场。

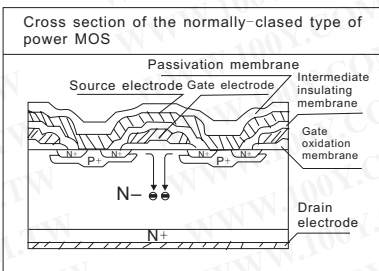
3. 通常闭合的型(2 形式B) 是低在电阻。

(所有AQO4 PhotoMOS 是形式B 类型。

形式A 类型且有低在电阻) 这由于固定

MOSFET由我们私有的方法处理, DSD

(双重散开的和有选择性掺杂) 方法。



4. 控制低级模拟信号

PhotoMOS中转以极端低闭路垂距电压为特色使能低级模拟信号控制没有畸变。

5. 高敏感性, 低在电阻

能控制最大0.13 A 装载电流以5 mA 输入电流。低落电阻 18Ω (AQV410EH), 稳定的操作因为无金属触点分开。

6. 低级状态泄漏电流

SSR有几毫安状态泄漏电流, 但PhotoMOS中转有typ. 100 pA 以额定的装载电压 400 V (AQV414E)。

7. 强化绝缘5,000 V 类型还可利用。

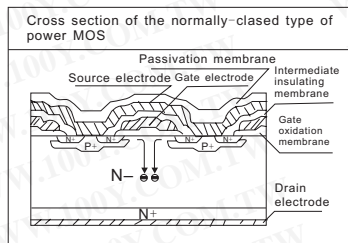
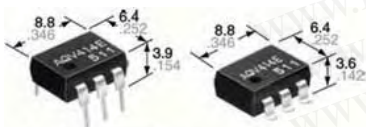
超过0.4 毫米内部绝缘距离在输入和输出之间。依照 EN41003, EN60950 (强化绝缘)。

### 典型应用:

- 电源
- 测量器材
- 安全设备
- 电话设备
- 传感器



100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
47312	AQV410EH	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 350V / 130mA	1 Form B	350V / 130mA	350V	UL(E43149),C-UL ,BSI	AQV410EH
47311	AQV412EH	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 60V / 550mA	1 Form B	60V / 550mA	60V	UL(E43149),C-UL	AQV412EH
47305	AQV414E	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 400V / 120mA	1 Form B	400V / 120mA	400V	UL(E43149),C-UL	AQV414E
47313	AQV414EH	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 400V / 120mA	1 Form B	400V / 120mA	400V	UL(E43149),C-UL,BSI,VDE	AQV414EH



### 特点:

1. 低电阻为正常型

这是体会的由于固定MOSFET 由我们私有的方法, DSD (双重扩散和有选择性掺杂) 处理方法。

2. 控制低级模拟信号

PhotoMOS中转以极端低闭路垂距电压为特色使能低级模拟信号控制没有畸变。

3. 高敏感性, 低ON电阻

能控制最大0.15 A 装载电流以5 mA 输入电流。

4. 低级状态泄漏电流

SSR有几毫安状态泄漏电流, 但PhotoMOS中转有typ. 100 pA 以400 V 额定装载电压。

### T典型应用:

- 电话设备 (Dial pulse)
- 测量器材

100Y 编号	厂商编号	制造厂商	说明	Contact Arrangement	Contact Rating	Coil Voltage	Recognized Safety	Type
47247	AQV414	NAIS	NAIS 继电器 DIP-6P 1500VAC / 400V/120mA	1 Form B	400V/120mA	400V	UL(E43149),C-UL	AQV414



服务专线: 台湾: 886-3-5753170

传 真: 台湾: 886-3-5753172

E-mail: 台湾: sale@100y.com.tw

深圳: 86-755-83298787

深圳: 86-755-83640655

深圳: 100y@163.com

上海: 86-21-34123367 & 54151736 29-84

上海: 86-21-64605107

上海: 100y-1@163.com